本期封面	2000年1期
	栏目:
	DOI:
论文题目:	透明导电氧化物ZnO: Al (ZAO) 薄膜的研究
作者姓名:	表志亮 谭明晖
工作单位:	中国科学院金属研究所, 沈阳 110015
通信作者:	裴志亮
通信作者Email	:
文章摘要:	用磁控反应溅射法制备了 Z n O : A l 薄膜,研究了薄膜方块电阻空间分布的均匀性及微观形貌,并对 Z n O : A l 薄膜表面各元素的化学状态和深度分布进行了 X P S π A E S S f
关键词:	Zn0: A1薄膜 电阻空间分布

关闭

0484 TN304.21

分类号: